19 BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENTAMT **® Offenlegungsschrift** 

® DE 195 25 903 A 1

(2) Aktenzeichen:

195 25 903.3

2 Anmeldetag:

8. 7.95

(3) Offenlegungsteg:

9. 1.97

61) Int. Cl.6: G 01 B 11/30 G 01 N 21/84 // (H01L 21/88,G01B 121:02)

(ii) Anmelder:

Institut für Halbleiterphysik Frankfurt (Oder) GmbH, 15230 Frankfurt, DE

② Erfinder:

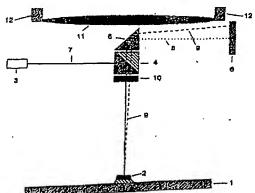
Elchler, Michael, 15232 Frankfurt, DE; Weldner, Marita, 15234 Frankfurt, DE; Marczinski, Paul, 15234 Frankfurt, DE

Entgegenhaltungen:

22 41 817 DE-AS 41 38 562 A1 DE DE 34 28 718 A1

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (6) Vorrichtung zur Auswertung der Oberflächene igenschaften von reflektierenden Meßobjekten mit kielnen Abmaßen
  - In der Vorrichtung wird ein feiner paralleler Lichtstrahl (7) einer Laserlichtquelle (3) in einen, innerhelb der optischen Anordnung en einem Strahlteilerwürfel (4) erzeugten Referenzstrahi (8) und einen von der Meßprobe reflektierten und über einen steuerbaren Verschluß (10) abschaltbaren Meßstrahl (8) aufgespatten. Belde Strahlen werden nuf alner gemeinsemen Auswertesinrichtung (8) als Leuchtf ecke ab-gebilder. Ihre Lege gegeneinender wird für eine Biswertung der Ausrichtung der Meßprobenoberfläche (2) gegenüber der optischen Achse der Vorrichtung und ihre in ensitäts-profile für die Bewertung von Mikrorauhigkeiten genutzt. Die relativ kleine Vorrichtung wird gegenüber der relativ großen Objektivlinse eines Mikroskops (11) mit großem Arbeitsabstand so engeordnet, daß sich ihre die Komponenten außerhalb der Fokusebenen des Mikroskops befirden und die optische Achse des auf das Meßobjekt einfallenden Meßstrahls mit der optischen Achse des Mikroskopobjektive zusammenfällt. Die Vorrichtung wird beim Vermessen von Schichtsystemen mit kleinen Abmessungen auf Masken und Wafarn in der Bauelementefertigung oder bei der Vergütung von Werkstoffoberflächen bei gleichzeitiger inspektion über ein Mikroskop angewendet.



Die folgenden Angeben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen BUNDESDRUCKEREI 11.98 602 052/529

BNS page 1

INSDOCID: <0E\_\_\_\_\_19525903A1\_1\_>

4/25

## DE 195 25 903 A1

3

ximums, und selbst dann ist dieser Einfluß wegen der gegenüber dem zentralen Maximum relativ kleinen Intensitäten der Nebenmaxima sehr gering.

Die bei den Verwendung einiger herkömmlicher Systeme zur Meßprobenausrichtung für lichtoptische Meßverfahren übliche mechanische Umschaltung zwischen mikroskopischen Beobachtungsbetrieb zur Positionierung der Probe mit Hilfe des Kreuztisches entsprechend der Lage der Strukturdetails auf der Probenoberfläche und dem Autokollimatorbetrieb zur Justage 10 der Neigung der Probenoberfläche entfällt. Insbesondere für einen automatisierten Betrieb können beide Einstellvorgänge ständig simultan erfolgen.

Die relative Veränderung des Intensitätsprofils des Strahles nach der Reflexion an einer Meßprobenoberfläche mit Mikrorauhigkeit gegenüber dem Intensitätsprofil des Referenzstrahls kann zu einer Beurteilung der Mikrorauhigkeit, im einfachsten Fall zu einer Entscheidung über die prinzipielle Meßbarkeit der Probe mit den angewendeten lichtoptischen Meßverfahren, herangezogen werden.

Die Erfindung soll anhand zweier Ausführungsbeispiele näher erläutert werden.

In den zugehörigen Zeichnungen zeigen

Fig. 1 einen Schnitt durch die Vorrichtung und den 25 Strahlengang innerhalb der Vorrichtung, wobei cie Vorrichtung als Vorsatz für ein Mikroskop wirkt.

Fig. 2 einen Schnitt durch den Teil eines Mikroskops, in das die Vorrichtung integriert ist und den Strahlengang innerhalb der Vorrichtung.

Der prinzipielle Strahlengang innerhalb der Vorrichtung ist für beide Ausführungsbeispiele gleich, sc daß es genügt die Erläuterung anhand des ersten Ausführungsbeispiels (Fig. 1) vorzunehmen.

Eine Laserlichtquelle mit vorgesetzten Blendensy- 35 stem (3) erzeugt einen parallelen Lichtstrahl mit möglichst kleinem Strahldurchmesser.

Dieser einfallende Lichtstrahl (7) wird über einen Strahlteilerwürfel (4) auf das Meßobjekt, das im dargestellten Fall auf einem Einzelchip (2) besteht, der mit entsprechenden Montagefehlern auf einem Träger (1) befestigt ist, abgelenkt. Dabei entstehen zwei Strahlen (8) und (9), die im weiteren zur Auswertung herangezogen werden.

Durch senkrechte Reflexion des einfallenden Strahls 45 (7) an der Unterseite des Strahlteilerwürfels (4) wird ein Referenzstrahl (8) erzeugt, der zweckmäßigerweise über ein Reflexionsprisma oder Spiegel (5) auf einen Beobachtungsschirm (6) gelenkt wird.

Der andere Teil des Meßstrahls (7) durchdringt die 50 Unterseite des Strahlteilerwürfels (4), trägt nach der Reflexion am Einzelchip (2) als reflektierter Meßstrahl (9) die benötigten Informationen vom Meßobjekt und wird in Abhängigkeit von der Ausrichtung und den Eigenschaften der Obersäche des Einzelchips (2) ann thernd 55 parallel zum Referenzstrahl (8) auf den Beobachtungsschirm (6) gelenkt.

Auf dem Beobachtungsschirm (6), der für erweiterte Anwendungen aus einem zweidimensionalen lichtoptischen Sensor und einem angeschlossenen Bildverarbeitungssystem besteht, werden Referenzstrahl (8) und reflektierter Meßstrahl (9) gemeinsam abgebildet und können über eine Positionsauswertung und ein: Auswertung der Intensitätsprofile für die vorgeschenen Aufgaben ausgewertet werden.

Zusätzlich wird durch die Anordnung eines steuerbaren Verschlusses (10) in den Strahlengang des eir fallenden Strahls (7) nach dem Strahlteilerwürfel (4) eir e Verbesserung der Auswertung in der Weise erzielt werden, daß bei geschlossenen Verschluß (10) eine separate Auswertung des Referenzstrahls (8) ohne reflektierten Meßstrahl (9) erfolgt, während bei geöffneten Verschluß (10) die Überlagerung von Referenzstrahl (8) und reflektiertem Meßstrahl (9) ausgewertet wird. Dadurch wird eine vorteilhafte Bildung von Signaldifferenzen möglich, so daß z. B. auch das Signal des reflektierten Meßstrahls (9) ohne den Einfluß des nicht ansteuerbaren Referenzostrahls (8) berechnet werden kann.

## Bezugszeichenliste

- 1 Träger des zu vermessenden Einzelchips
- 2 zu vermessender Einzelchip
- 3 Laserlichtquelle mit Blendensystem
- 4 Strahlteilerwürfel
- 5. Umlenkspiegel
- 6 Beobachtungsschirm
- 7 einfallender paralleler Meßstrahl mit kleinem Durchmesser
- 8 von der Unterseite des Strahlteilerwürfels reflektierter Referenzstrahl
- 9 vom Einzelchip reflektierter Meßstrahl
- 10 Verschluß
- 11 große Objektivlinse des Mikroskops mit großem Arbeitsaufwand
- 12 Tubus des Mikroskops
- 13 Fenster in der Objektivlinse

## Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Auswertung der Oberflächeneigenschaften von reflektierenden Meßobjekten mit kleinen Abmaßen insbesondere bei Untersuchungen von dünnen Schichten mit ellipsometrischen und spektralphotometrischen Meßverfahren, dadurch gekennzeichnet, daß ein paralleler Lichtstrahl mit sehr kleinem Durchmesser, vorzugsweise aus einer Laserlichtquelle, in einen, innerhalb der optischen Anordnung an einem Strahlteilerwürfel erzeugten Referenzstrahl und einen von der Meßprobe restektierten Meßstrahl aufgespalteten wird, beide Strahlen auf einer gemeinsamen Auswerteeinrichtung, die aus einem Beobachtungsschirm oder einem Bildverarbeitungssystem besteht, als Leuchtslecken abgebildet werden, und die Lage dieser Leuchtslecke gegeneinander für eine Bewertung der Ausrichtung der Meßprobenoberfläche gegenüber der optischen Achse der Vorrichtung und ihre Intensitätsprofile für die Bewertung von Mikrorauhigkeiten auf der Probenoberfläche genutzt werden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein steuerbarer Verschluß im Strahlengang des von der Meßprobe reflektierten Meßstrahls angeordnet ist und bei geschlossenem Verschluß nur der Referenzstrahl, bei geöffneten Verschluß der Referenzstrahl und von der Meßprobe reflektierter Meßstrahl in die Auswerteeinrichtung gelangen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die in ihren kritischen geometrischen Abmessungen gegenüber der großen Objektivlinse eines Mikroskops mit großen Arbeitsabstand kleine Vorrichtung außerhalb oder innerhalb desloptischen Aufbaus dieses Mikroskops so angeordnet wird, daß sich die Komponenten der Vor-

3NSDOCIO: -OE\_\_\_\_\_19525903A1\_I\_>

BNS page 3

PAGE 32/57 \* RCVD AT 2/22/2007 5:00:52 PM [Eastern Standard Time] \* SVR:USPTO-EFXRF-3/20 \* DNIS:2738300 \* CSID:858 597 1585 \* DURATION (mm-ss):29-52

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer: Int. Cl.<sup>5</sup>: DE 195 25 903 A1 G 01 B 11/30

Offenlegungstag:

9. Januar 1997

6

7

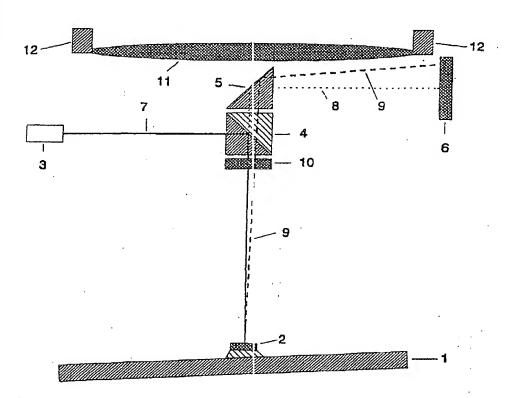


Fig. 1

602 062/529

INSOOCID: <DE\_\_\_\_19525903A1\_1\_>

BNS page 5

PAGE 33157 \* RCVD AT 2/22/2007 5:00:52 PM [Eastern Standard Time] \* SVR: USPTO-EFXRF-3/20 \* DNIS: 2738300 \* CSID: 858 597 1585 \* DURATION (mm-ss): 29-52

ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer:

DE 195 25 903 A1

Int. Cl.<sup>8</sup>: Offenlegungstag: **G 01 B 11/30** 9. Januar 1997

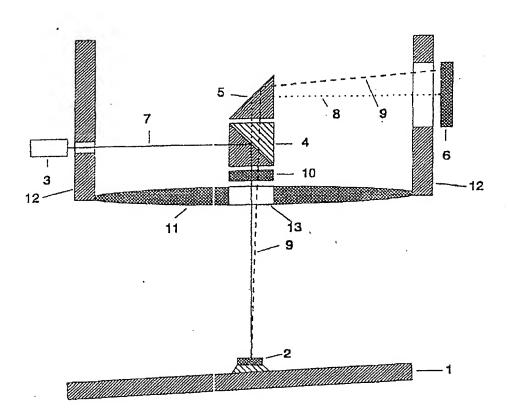


Fig. 2

602 062/529

BNS page 6

BNSDOGID: «DE\_\_\_\_\_18525903A1\_1\_>